

1. Procedeu de curățire a utilajului tehnologic de deșeuri după creșterea epitaxială a straturilor semiconductoare de tipul A^3B^5 , care include tratarea chimică a părții utilajului tehnologic cu deșeuri prin afundarea într-un vas cu soluție acidă, care conține un amestec de acid azotic HNO_3 și acid clorhidric HCl , și spălarea lui ulterioară cu apă deionizată și uscarea, caracterizat prin aceea că tratarea chimică se efectuează cu soluție acidă care conține 25 ... 52%vol. de acid azotic HNO_3 , totodată soluția acidă prealabil se degazează timp de 1,5 ... 4 ore.
2. Procedeu de curățire a utilajului tehnologic de deșeuri după creșterea epitaxială a straturilor semiconductoare de tipul A^3B^5 , conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că degazarea prealabilă a soluției acide se efectuează în apă deionizată.